

2Т363А, 2Т363Б, КТ363А, КТ363Б, КТ363АМ, КТ363БМ
Высокочастотные р-п-р транзисторы малой мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_{гр} = 1,0$ ГГц гр. А, АМ; 1,5 ГГц гр. Б, БМ
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{Кmax} = 150$ мВт гр. А, Б; 200 мВт гр. АМ, БМ
Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{Кэmax} = 15$ В (2Т363А, КТ363А, КТ363АМ); 12 В (2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ)

Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса	Диапазон рабочих температур
2Т363А, Б	ЩТО.336.008 ТУ	КТ-1-7 (ТО-18)	-60°C до +125°C
КТ363А, Б	ЩТО.336.014 ТУ	КТ-1-7 (ТО-18)	-45°C до +85°C
КТ363АМ, БМ	ЩТО.336.014 ТУ	КТ-26 (ТО-92)	-45°C до +85°C

Кремниевые планарно-эпитаксиальные р-п-р высокочастотные транзисторы 2Т363А, 2Т363Б, КТ363А, КТ363Б, КТ363АМ, КТ363БМ предназначены для применения в схемах усиления и переключения радиоэлектронной аппаратуры.

Маркировка транзисторов в соответствии с техническими условиями ЩТО.336.008ТУ и ЩТО.336.014 ТУ. Знаком ОСМ обозначаются изделия повышенной надежности.

Схема расположения выводов



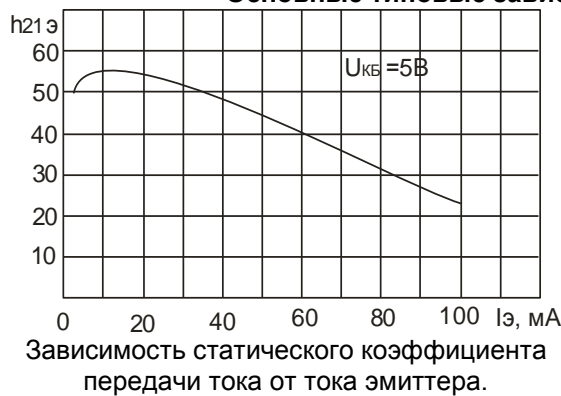
Основные электрические параметры при $T = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		2Т363А, КТ363А, КТ363АМ		2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ	
		не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{КБ} = 15$ В), мкА	$I_{КБО}$		0,5		0,5
Обратный ток эмиттера ($U_{КБ} = 4$ В), мкА	$I_{ЭБО}$		0,5		0,5
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 5$ мА, $t_{и} < 2$ мс)	$h_{21Э}$	20	120	40	120
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 5$ мА, $f = 100$ МГц)	$ h_{21Э} $	10		15	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_{К} = 10$ мА, $I_{Б} = 1$ мА), В	$U_{Энас}$		0,35		0,35
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_{К} = 10$ мА, $I_{Б} = 1$ мА), В	$U_{БЭнас}$		1,1		1,1
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 5$ мА, $f = 30$ МГц), пс	$\tau_{К}$		50		75
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ} = 5$ В, $f = 10$ МГц), пФ	$C_{К}$		2		2
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ} = 0$ В, $f = 10$ МГц), пФ	$C_{Э}$		2		2
Время рассасывания ($I_{К} = 10$ мА, $I_{Б} = 1$ мА, $I_{К} = 10$ мА, $I_{Б} = 0,5$ мА), нс	$t_{РАС}$		10		5

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

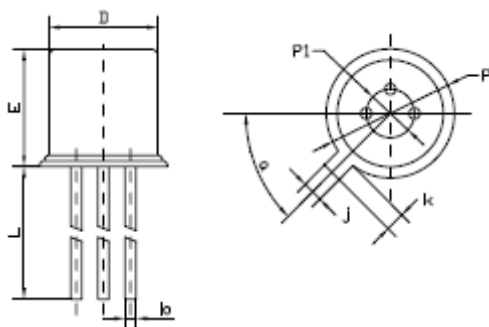
Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Предельный режим			
		2Т363А, КТ363А	2Т363Б, КТ363Б	КТ363АМ	КТ363БМ
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБmax}$	15	15	15	15
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В при $R_{ЭБ} \leq 1 \text{ кОм}$, при $R_{ЭБ} \leq 10 \text{ кОм}$	$U_{КЭmax}$	15 10	12 10	15 10	12 10
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБmax}$	4	4	4	4
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{Кmax}$	30	30	30	30
Максимально допустимый импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10 \text{ мкс}$, $Q > 2$, мА	$I_{КИmax}$	50	50	50	50
Максимально допустимая рассеиваемая мощность коллектора, мВт при $T \leq +45^\circ \text{C}$ при $T = +85^\circ \text{C}$ для КТ363А,Б и КТ363АМ, БМ при $T = +125^\circ \text{C}$ для 2Т363А,Б	$P_{Кmax}$	150 93 36	150 93 36	200 93	200 93
Импульсная рассеиваемая мощность, мВт	$P_{Иmax}$	$1,5 P_{Кmax}$	$1,5 P_{Кmax}$	-	-
Общее тепловое сопротивление, $^\circ \text{C}/\text{Вт}$	R_{thia}	700	700	700	700

Основные типовые зависимости параметров транзисторов

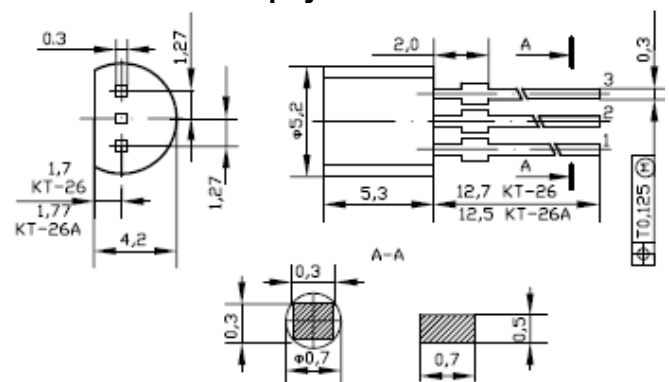


Габаритные чертежи используемых корпусов

Корпус КТ-1-7



Корпус КТ-26



Размеры	мм	
	min	max
b		0,5
E		5,4
D		4,95
L	12,5	14,5
P		5,84
P1	2,2	2,6
J	0,94	1,12
k	0,88	1,12
α	40°	50°

Примечание:
Допускается отсутствие выступов на выводах.
Позиционный допуск на расстоянии 2,0 мм max.

- 1 – Коллектор
- 2 – База
- 3 – Эмиттер